

EpiGaN erweitert Produktion von GaN-Leistungselektronik mit AIX G5+ C

Führender europäischer Anbieter von GaN-basierten Technologielösungen setzt auf MOCVD-Produktionsanlage von AIXTRON

Herzogenrath, 13. November 2018 – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein weltweit führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, gibt bekannt, dass EpiGaN eine AIX G5+ C MOCVD-Anlage zur Erhöhung der Produktionskapazität von GaN-on-Si¹- und GaN-on-SiC²-Epiwafern mit großem Durchmesser bestellt hat. Das belgische Unternehmen ist spezialisiert auf GaN-on-Si- und GaN-on-SiC-basierte Materialproduktlösungen für zukunftsweisende Halbleiterbauelemente, die vor allem in der Telekommunikation, Leistungselektronik und Sensorik zum Einsatz kommen.

Die neue AIX G5+ C-Anlage von AIXTRON wird in Q1/2019 am Produktionsstandort von EpiGaN in Hasselt (Belgien) installiert und in Betrieb genommen. Die vollautomatische MOCVD-Planetenanlage verfügt über eine In-situ-Kammerreinigung und ermöglicht Konfigurationen von 8x6 Zoll- oder 5x8 Zoll-Epiwafern, die mittels eines Wafer-Transfermoduls für den Kassettenbetrieb („*cassette-to-cassette*“) automatisch geladen und entladen werden können.

"Die Nachfrage unserer weltweiten Kundenbasis nach GaN-Produktlösungen steigt. Unsere Hauptkunden bereiten sich auf die Markteinführung und Vergrößerung von Produkten vor, die auf unserer GaN-HF-Leistungstechnologie basieren, die für 5G-Breitbandnetzanwendungen optimiert ist. Mit der AIX G5+ C Planetenanlage von AIXTRON wird EpiGaN seine Kapazität für 150mm- und 200mm-Produktlösungen erhöhen, um die steigend Marktnachfrage zu befriedigen", sagt EpiGaN-Mitbegründerin und CEO Dr. Marianne Germain. "Die AIXTRON-Planetenanlage kombiniert exzellente Homogenität der Wafer und Run-to-Run-Leistung mit niedrigsten Betriebskosten – entscheidenden Faktoren, um unseren Kunden herausragende und leistungsfähige Produkte zum richtigen Preis anbieten zu können."

Dr. Felix Grawert, President von AIXTRON, sagt: "Wir sind überzeugt, dass die AIX G5+ C den hohen Anforderungen von EpiGaN an eine qualitativ hochwertige Massenproduktion GaN-basierter Epiwafer gerecht wird. Denn unsere Anlage erfüllt die höchsten Standards hinsichtlich Homogenität der Wafer und Partikel-Anzahl."

Erst kürzlich hat EpiGaN Versionen mit großem Durchmesser seiner HVRF (High Voltage Radio Frequency) GaN-on-Si- sowie GaN-on-SiC-Wafer-Produktfamilien auf den Markt gebracht, die auf anspruchsvolle 5G-Anwendungen zugeschnitten sind. Mit der neuen AIX G5+ C MOCVD-Anlage von AIXTRON erwartet EpiGaN eine schnelle Vergrößerung und Verbreitung seiner differenzierten Technologielösungen auf dem Weltmarkt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.com WEB www.aixtron.com

¹ GaN-on-Si = Galliumnitrid-auf-Silizium, ² GaN-on-SiC = Galliumnitrid-auf-Siliziumkarbid

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT[®], AIXTRON[®], APEVA[®], Atomic Level Solutions[®], Close Coupled Showerhead[®], CRIUS[®], EXP[®], EPISON[®], Gas Foil Rotation[®], Optacap[™], OVPD[®], Planetary Reactor[®], PVPD[®], STEXS[®], TriJet[®]

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Über EpiGaN

EpiGaN wurde 2010 gegründet und bietet seinem weltweiten Kundenkreis innovative GaN-Technologie-Lösungen an. Ausgehend von der Europazentrale und dem modernen Produktionsstandort in Hasselt (Belgien) bietet das Unternehmen einen frühzeitigen Zugang zu modernster GaN/Si- und GaN/SiC-Epiwafer-Technologie für zukunftsweisende Leistungsschalter-, HF-Energie- und fortschrittliche Sensorlösungen. Die GaN-Technologie von EpiGaN ist ein Schlüsselfaktor für innovative Bauelemente in Verbrauchernetzteilen, Elektrofahrzeugen, drahtlosen Lade- und HF-Energiesystemen für Mobilfunkinfrastrukturen der nächsten Generation - 5G, IoT (Internet der Dinge) und intelligente Sensorsysteme. Das Produktspektrum reicht von anwendungsspezifischen Standard-Epiwafern mit einem Durchmesser von bis zu 200mm bis hin zu kundenspezifischen Produkten, welche die differenzierende Technologie des Unternehmens bei AlN-Barriere- und in-situ SiN-Passivierungsschichten nutzen.

Für weitere Informationen über EpiGaN nv besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.epigan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.com WEB www.aixtron.com